

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum GaN	7
2.2. Sifat Listrik GaN	9
2.3. Sifat Optik GaN.....	11
2.4. Model Jalur Energi Metal Dengan Semikonduktor.....	12

2.5. Transport Arus Pada Barrier Schotky	14
2.6. Kontak Ohmik	16
2.7. Karakteristik I-V Pada Kontak Metal-Semikonduktor.....	17
2.8 Fotokonduktor	20
2.8.1. Struktur Fotokonduktor	21
2.8.2 Karakteristik Listrik Fotokonduktor	21
2.8.3 Unjuk Kerja Fotokonduktor	23

BAB III EKSPERIMEN DAN KARAKTERISASI

3.1. Ukuran Dan Sifat Listrik Film Tipis Galium Nitrida (GaN).....	26
3.2. Pembuatan Kontak Metal - Semikonduktor	27
3.3. Karakterisasi Fotokonduktor Al/n-GaN	34
3.3.1. Karakteristik Responsivitas.....	34
3.3.2. Karakterisasi I-V	34

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakterisasi Responsivitas	37
4.2. Karakterisasi I-V	41
4.2.1. Karakterisasi I-V Pada Kondisi Tanpa Penyinaran (Gelap).....	42
4.2.2. Karakterisasi I-V Pada Kondisi Penyinaran.....	45

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	48
5.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN – A	i
LAMPIRAN – B	iii
LAMPIRAN – C	iv
LAMPIRAN – D	v
LAMPIRAN – E	vi
LAMPIRAN – F	vi
LAMPIRAN – G	vii
LAMPIRAN – H	viii